



بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
۲۳ تا ۲۵ دی ماه ۱۳۹۳، دانشگاه شهید بهشتی



بررسی افزایش حساسیت ضریب فرنل به ضریب شکست با لایه نشانی گرافین در مرز دو دی الکتریک

حامد نیکبخت، معصومه پاک و حمید لطیفی

پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران، ایران

چکیده - تغییر حساسیت ضرایب فرنل در مرز دو دی الکتریک به ضریب شکست می تواند در بهبود عملکرد حسگرهای ضریب شکست نقش بسزایی ایفا کند. در این مقاله ضرایب فرنل برای مرز دو محیط در حضور لایه گرافین در مرز محاسبه شده است. با استفاده از مشتق ضریب بازتاب فرنل نسبت به ضریب شکست محیط دوم، تاثیر مثبت لایه نشانی گرافین بر حساسیت ضریب شکستی ضریب بازتاب فرنل نشان داده شده است.

کلید واژه - حسگر ضریب شکست، گرافین، ضرایب فرنل

Investigation of sensitivity enhancement of Fresnel coefficients with Graphene coating in dielectric boundary

Hamed Nikbakht, Masome Pak, and Hamid Latifi

Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Evin, Tehran, Iran.

Abstract- changing sensitivity of Fresnel coefficient to refractive index in boundary of two dielectric can enhance refractive index functionality. In this paper Fresnel coefficient for boundary of two dielectric in presence of Graphene layer is calculated. Positive effect of Graphene coating on refractive index sensitivity of Fresnel reflection coefficient is demonstration utilizing reflection coefficient derivative relative to second medium refractive index.

Keywords: Refractive index sensor, Graphene, Fresnel coefficient

۱- مقدمه

مرز دو محیط در دو حالت بدون لایه نشانی گرافین و با لایه نشانی گرافین محاسبه شده است.

در حالتی که گرافین روی مرز وجود ندارد ضرایب فرنل برای دو قطبش TE و TM به شکل زیر است [۱]:

$$r_s = \frac{n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t} \quad (1)$$

$$t_s = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t} \quad (2)$$

$$r_p = \frac{n_2 \cos \theta_i - n_1 \cos \theta_t}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t} \quad (3)$$

$$t_p = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t} \quad (4)$$

که در آن $\theta_t, \theta_i, n_2, n_1$ به ترتیب از راست ضریب شکست محیط اول، ضریب شکست محیط دوم، زاویه نور فرودی، زاویه نور عبوری می باشد. در حالت دوم روابط فرنل با فرض در نظر گرفتن گرافین به شکل یک جریان سطحی بر روی مرز محاسبه می شود. دوبعدی بودن گرافین و رسانندگی بالای آن علت این امر می باشد. شکل های (۱) و (۲) این جریان سطحی را نشان می دهند.

برای به دست آوردن ضرایب فرنل در حضور گرافین از مدلی استفاده شده که هدایت نرمالیزه است و نیازی به ضریب شکست گرافین نیست. هدایت نرمالیزه عبارتست از

$$G = m z_0 \sigma_0 \quad (5)$$

$$z_0 \sigma_0 = \pi \alpha \quad (6)$$

با توجه به رابطه (۵) و (۶) داریم:

$$G = m \pi \alpha, \quad \alpha = \frac{1}{137} \quad (7)$$

شرایط مرزی برای میدان های الکترومغناطیسی عبارتست از:

$$n \times (E_2 - E_1) = 0 \quad (8)$$

$$n \times (H_2 - H_1) = J_s \quad (9)$$

گرافین ماده ای است با پایه کربنی که انتظار می رود انقلابی بزرگ در عرصه تکنولوژی ایجاد کند و در هرچه باهوش تر، سریعتر و دقیق تر شدن دنیای آینده نقش داشته باشد. گرافین ساختار دو بعدی و تک لایه با شبکه لانه زنبوری کربنی می باشد. در این ساختار هر اتم کربن با ۳ اتم کربن دیگر پیوند کووالانسی به طول ۰٫۱۴۲ نانومتر دارد. گرافین به دلیل داشتن خواص فوق العاده در رسانندگی، رسانندگی گرمایی، چگالی بالا، تحرک پذیری حامل های بار، رسانندگی اپتیکی و خواص مکانیکی به ماده ای منحصر به فرد تبدیل شده است [۱،۲].

این ویژگی ها گرافین را به عنوان گزینه ی بسیار مناسبی برای طراحی نسل بعدی قطعه های الکترونیکی و نوری هم چون ترانزیستورهای بالستیک، ساطع کننده های میدان، عناصر مدارهای مجتمع، الکترودهای رسانای شفاف و حسگرها مطرح کرده است. همچنین، رسانندگی الکتریکی و گذردهی نوری بالای گرافین، آن را به عنوان ماده ای مناسب برای الکترودهای رسانای شفاف، که مورد استفاده در صفحه های لمسی و نمایشگرهای بلوری مایع و سلول های فوتوالکتریک و به علاوه دیودهای آلی ساطع کننده نور (OLED) معرفی می کند [۳،۴].

دو بعدی بودن گرافین سبب شده تا قرارگیری این ماده بر روی سطح به صورت قرارگرفتن در مرز دو محیط دی الکتریک باشد. وقتی نور به مرز دو محیط برخورد می کند بخشی از نور بازتاب و بخشی عبور خواهد کرد که ضرایب فرنل تعریف شده ای برای بازتاب و عبور از هر مرز وجود دارد. این ضرایب به ضریب شکست محیط دو طرف مرز وابسته هستند. به عبارت دیگر تغییرات در ضریب شکست هر محیط ضرایب فرنل را تغییر می دهد. وابستگی ضریب بازتاب به ضریب شکست موجب وابستگی حساسیت ضریب شکست به حساسیت ضریب بازتاب شده است. پس هر چه حساسیت ضریب بازتاب بیشتر باشد، با استفاده از آن می توان به حسگرهای دقیق تری دست یافت.

۲- تئوری

برای بررسی میزان حساسیت ضریب بازتاب ابتدا باید ضرایب بازتاب و عبور فرنل محاسبه شود. این ضرایب برای

که در آن $E_t, E_r, E_i, H_t, H_r, H_i, m$ به ترتیب از راست تعداد لایه های گرافین، میدان مغناطیسی نور فرودی، بازتابی، عبوری، میدان الکتریکی نور فرودی، بازتابی، عبوری می باشد.

۳- نتایج

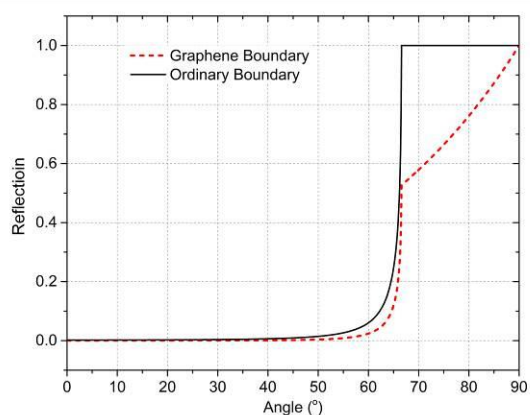
برای به دست آوردن توان بازتاب از رابطه ی زیر استفاده می شود:

$$R_s = |r_s|^2 \quad (20)$$

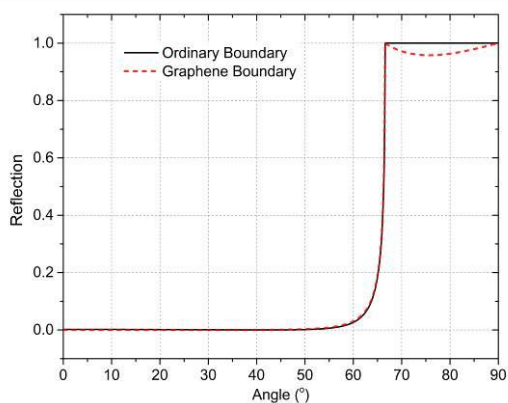
$$T_s = \frac{n_2}{n_1} |t_s|^2 \quad (21)$$

نمودار توان بازتاب - زاویه:

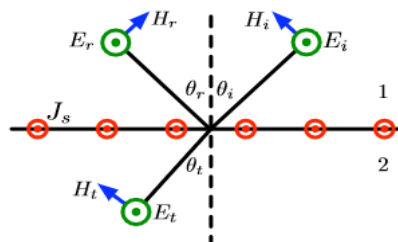
شکل های (۳) و (۴) رابطه ی توان بازتاب بر حسب زاویه را در دو حالت بدون گرافین و با گرافین در قطبش TE و TM نشان می دهند.



شکل ۳- نمودار توان بازتاب - زاویه در قطبش TE



شکل ۴- نمودار توان بازتاب - زاویه در قطبش TM



شکل ۱- میدان های الکتریکی و مغناطیسی در قطبش S

$$E_i + E_r = E_t \quad (10)$$

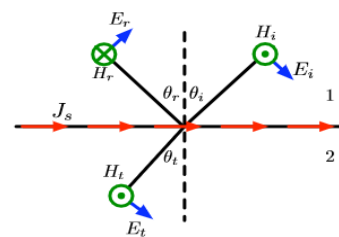
$$H_i \cos \theta_i - H_r \cos \theta_r = H_t \cos \theta_t + J_s \quad (11)$$

$$J_s = m\pi\alpha \quad (12)$$

در نتیجه ضرایب بازتاب و عبور فرنل در قطبش S عبارتند از:

$$r_s = \frac{n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_t - m\pi\alpha}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t + m\pi\alpha} \quad (13)$$

$$t_s = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t + m\pi\alpha} \quad (14)$$



شکل ۲- میدان های الکتریکی و مغناطیسی در قطبش P

$$H_i - H_r = H_t + J_s \quad (15)$$

$$E_i \cos \theta_i + E_r \cos \theta_r = E_t \cos \theta_t \quad (16)$$

$$J_s = m\pi\alpha \cos \theta_t \quad (17)$$

در نتیجه ضرایب بازتاب و عبور فرنل در قطبش P عبارتند از:

$$r_p = \frac{n_1 \cos \theta_t - n_2 \cos \theta_i - m\pi\alpha \cos \theta_t \cos \theta_i}{n_1 \cos \theta_t + n_2 \cos \theta_i + m\pi\alpha \cos \theta_t \cos \theta_i} \quad (18)$$

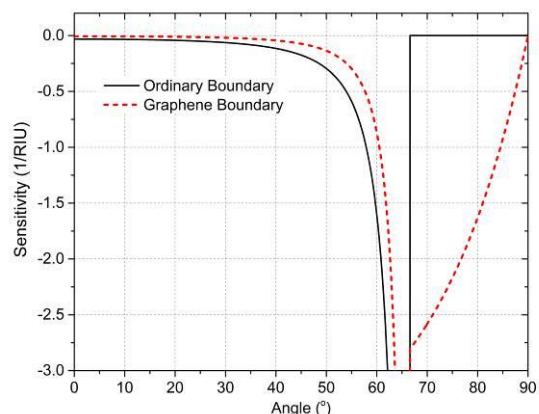
$$t_p = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_1 \cos \theta_t + n_2 \cos \theta_i + m\pi\alpha \cos \theta_t \cos \theta_i} \quad (19)$$

مراجع

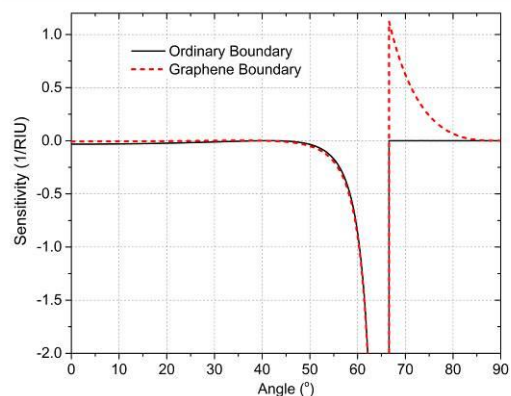
- [1] Nair R.R., P. Blake, A.N. Grigorenko, et al. *Fine structure constant defines visual transparency of graphene*. **Science** 320 (2008) 1308
- [2] Geim A.K., and P. Kim. Carbon wonderland. **Scientific American** 298 (2007) 90–97.
- [3] Lu, C.H., Zhu, C.L., Chen, G.N., *A Graphene Platform for Sensing Biomolecules*, **Angewandte Chemie International Edition** 48 (2009) 4785-4787.
- [4] Stine, R., Robinson, J.T., Sheehan, P.E., Tamanaha, C.R., *Real-Time DNA Detection Using Reduced Graphene Oxide Field Effect Transistors*, **Advanced Materials** 22 (2010) 5297-5300.
- [5] Novoselov K.S., Geim A.K., Morozov S.V., Jiang D., Zhang Y., Dubonos S.V., Grigorieva I.V., Firsov, A.A., *Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films*, **Science**, 306 (2004) 666–669.
- [6] Heyrovská R., *Atomic Structures of Graphene, Benzene and Methane with Bond Lengths as Sums of the Single, Double and Resonance Bond Radii of Carbon*, **Appl. Phys. Lett.** 208 (2009) 1987-1992
- [7] Katsnelson M., *Graphene: Carbon in Two Dimensions*, **Materials today**, 10 (2007) 20–27.
- [8] Jackson J.D., *Classical Electrodynamics*, 3rd ed, John Wiley & Sons Inc, 2001.

نمودار حساسیت توان بازتاب - زاویه:

تغییرات ضریب شکست محیط دوم باعث تغییر ضریب بازتاب و در نتیجه تغییر توان بازتاب خواهد شد. با مشتق گیری از رابطه‌ی توان بازتاب نسبت به n_2 حساسیت توان بازتاب به دست می‌آید. در شکل (۵) و (۶) حساسیت توان بازتاب بر حسب زاویه برای دو حالت بدون گرافین و با گرافین در قطبش TE و TM نشان داده شده است.



شکل ۵- نمودار حساسیت توان بازتاب - زاویه در قطبش TE



شکل ۶- نمودار حساسیت توان بازتاب - زاویه در قطبش TM

۴- نتیجه‌گیری

وابستگی توان بازتاب به ضریب شکست موجب شده که تغییر ضرایب فرنل بر روی حساسیت ضریب شکست تاثیر بگذارد. در نتیجه افزایش حساسیت توان بازتاب، حساسیت ضریب شکست حسگر را افزایش می‌دهند. از آنجا که اکثر حسگرهای نوری در زاویه‌های بزرگتر از زاویه‌ی حد کار می‌کنند نتایج نشان می‌دهند که حضور گرافین موجب افزایش حساسیت در حسگرهای نوری خواهد شد.